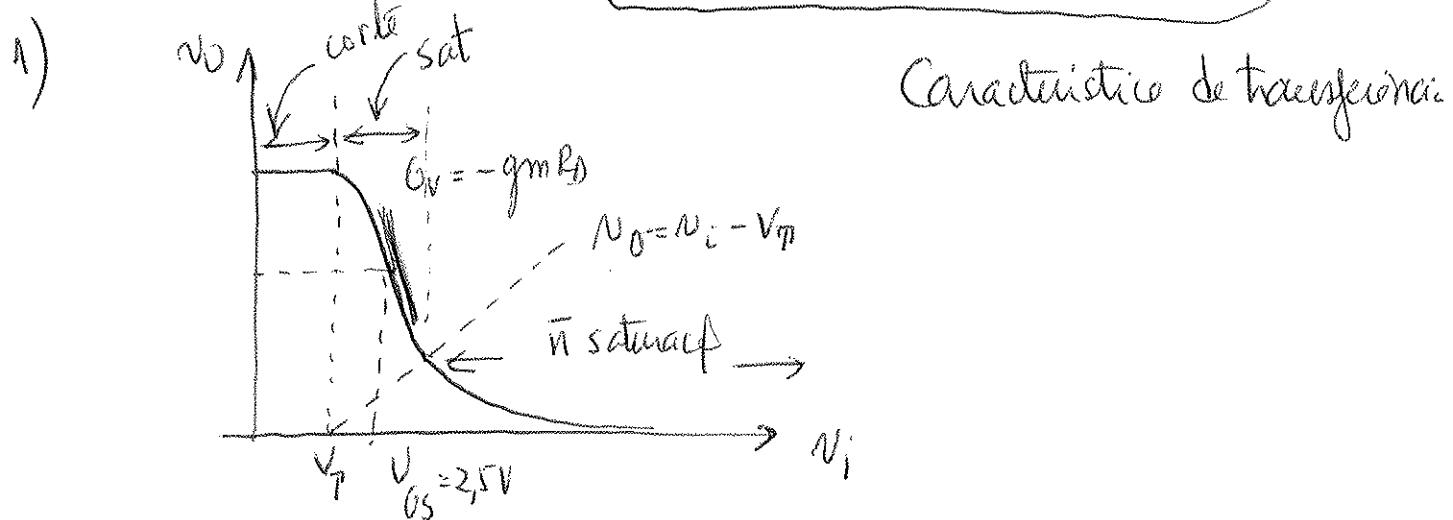


NOTAS SOBRE OAB. MOSFET



do declive do recto tangente à curva $N_D = N_0(V_i)$ no ponto P tiram a valor de g_m .

2) Saturação $V_{DS} > V_{DSs} = V_{DS} - k$

$$I_D = \frac{A}{2} (V_{DS} - V_T)^2 \Rightarrow \sqrt{I_D} = \sqrt{\frac{A}{2}} (V_{DS} - k)$$

A recta $\sqrt{I_D} = f(V_{DS}) \Rightarrow y = mx + b$

$$y = \sqrt{I_D} \quad [mA^{1/2}]$$

$$m = \sqrt{\frac{A}{2}} \Rightarrow \boxed{A = 2m^2} \quad (mA/V^2)$$

$$b = -mV_T \Rightarrow \boxed{V_T = -\frac{b}{m}}$$

O declive da recta $\sqrt{I_D} = f(V_{DS})$ permite obter A

A adiante na origem e o declive permite obter V_T

No PSPice $k_p \frac{W}{L} = A \Rightarrow \boxed{k_p = A \left(\frac{L}{W} \right)}$

$$\left(\frac{dI_D}{dV_{DS}} \right) = A(V_{GS} - V_T) = g_m$$

$$V_{DS} = V_{GS} = 2,5 \text{ V}$$

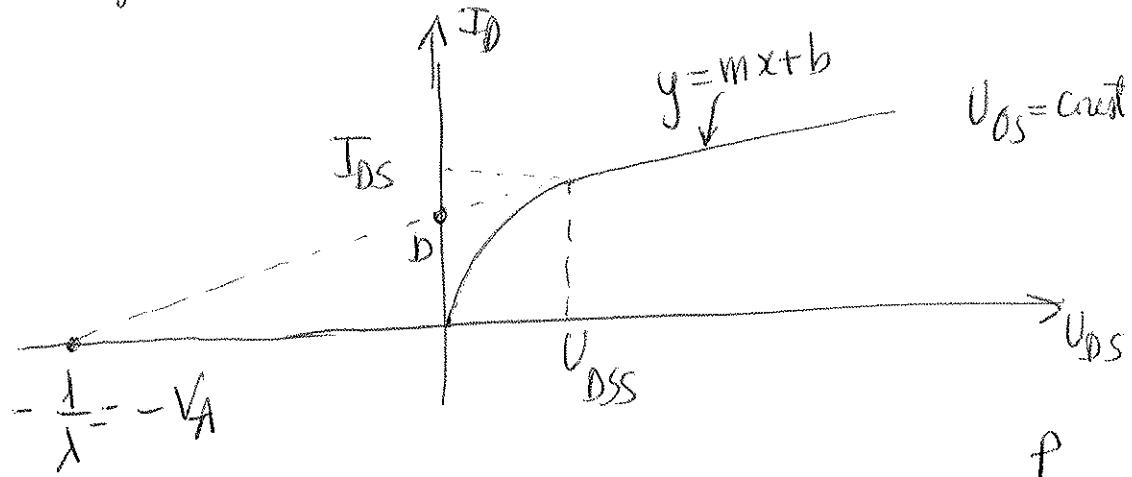
3) $V_{BS} + R_S I_D = 0 \Rightarrow \boxed{V_{BS} = -R_S I_D} < 0$

$$I_D = \frac{A}{2} (V_{GS} - V_T^*)^2 \Rightarrow \text{novo valo} \cancel{de} V_T^* > V_T \\ (V_{BS} < 0)$$

$$g = \frac{\Delta V_T}{\sqrt{g_{SD} \cdot V_{BS} - \sqrt{g_{SD} \cdot V_{BS}}}} \rightarrow \text{fazendo no Pspice entre os dois casos de } V_T$$

$$\Delta V_T = V_T^* - V_T > 0$$

4) Efeito do modelo do cond



$r_{DS} = \frac{1}{m}$ → o declive na zona de saturação permanece constante e parâmetro r_{DS} .

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{DS}} \Big|_{V_{DS}=3}$$